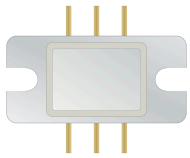
2000–8000 MHz GaN 패키지형 전력 증폭기 — PSAT 42.5 dBm (대표값)

LCI-PA-2000-8000-PS42p5T · 2000–8000 MHz · GaN 패키지형 전력 증폭기.



RF 전기 특성표의 규격값: PSAT 42.5 dBm (대표값); 전력 이득 15.5 dB (대표값); PAE 28 % (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW.

CMW010B

게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

패키지 외형 치수: 18.03 × 8.7 mm.

RF 특성

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	2000	-	8000	MHz
포화 출력 전력	-	40	42.5	-	dBm
전력 이득	-	13	15.5	-	dB
전력 부가 효율	-	25	28	-	%
전력 이득 평탄도	-	-	-	±1.5	dB

DC 바이어스 및 전류

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
드레인 전압	-	-	-	-	28	V
게이트 전압	-	-	-	-	-2.4	V

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	-	-	-	32	V
게이트 바이어스 하한	-	-5	-	-	V
보관 온도	-	-65	-	150	°C

패키지 외형 치수

항목	값	단위
패키지 외형 치수	18.03 × 8.7	mm
단자 전체 폭	14.7	mm

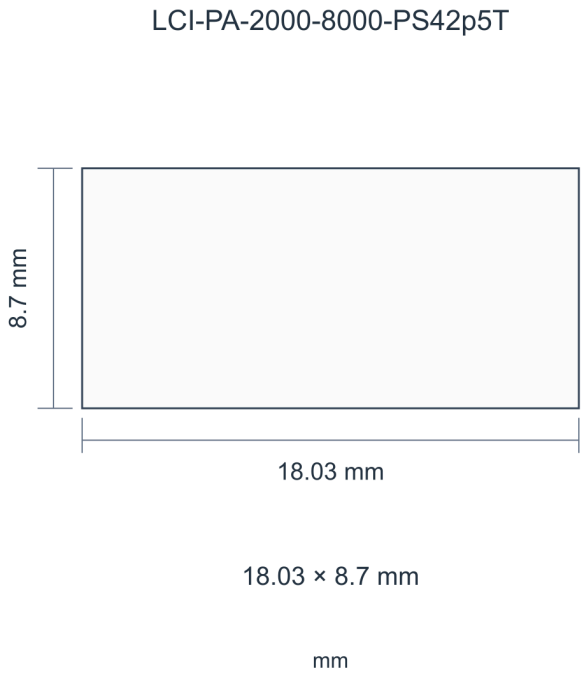
현재 발행 기록 · 1.6 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.5.

통합 설계 안내

CMW010B 게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

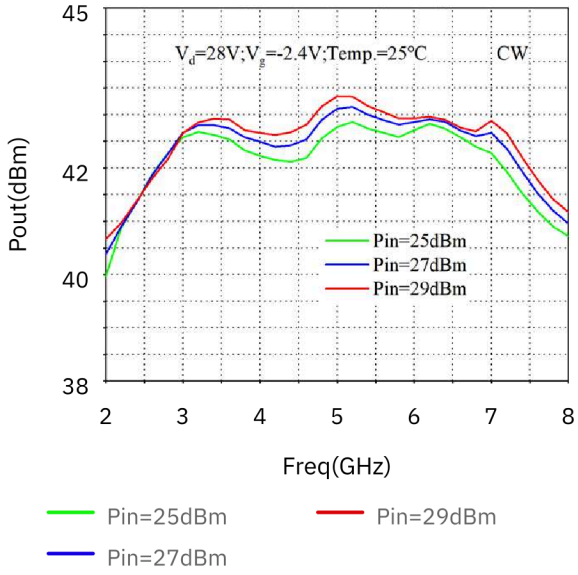
기구 외형도

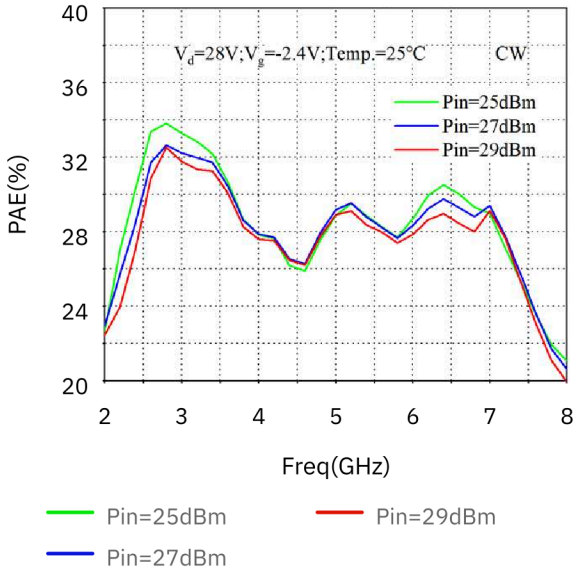
확인된 치수를 mm로 표시한 부분 도면입니다. 설치 시 전체 설치 도면을 참조하십시오.

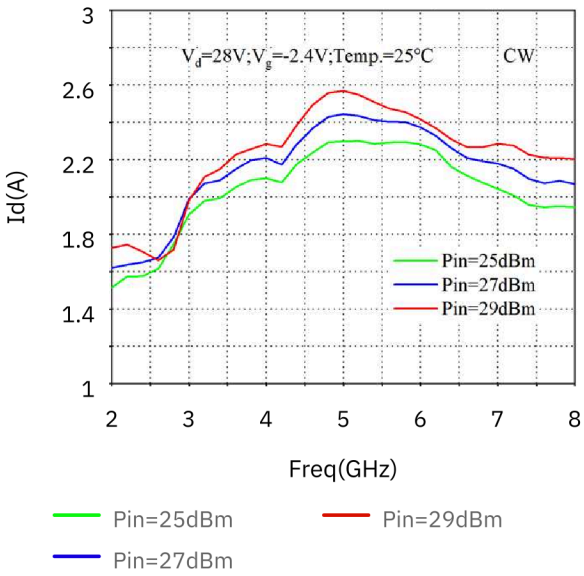


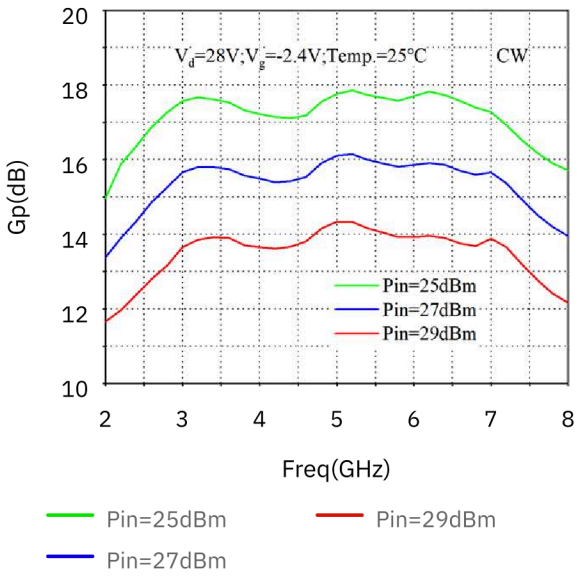
성능 특성 곡선

각 성능 그래프는 해당 그림에 표시된 동작 조건에서의 특성을 보여 줍니다.









출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 전류; 전력 이득. Vd = 28 V; Vg = -2.4 V; TA = 25 °C; CW; Pin = 25/27/29 dBm.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.